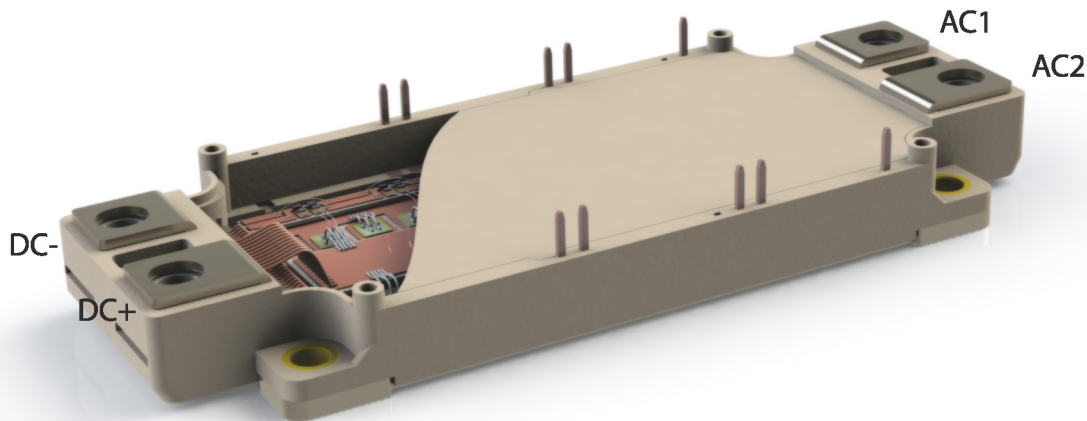




МОДУЛЬ MSCA

Низкоиндуктивный Full-SiC модуль 1200В 500А
по схеме полумост / полный мост в стандартном корпусе



ОСОБЕННОСТИ:

- Модуль Full-SiC на основе чипов SiC MOSFET и SiC SBD последнего поколения
- Очень низкая индуктивность (<8 нГн) в стандартном корпусе
- Конфигурация H-моста (250А) или полумоста (500А)
- Топология переключающих ячеек
- Низкое значение $R_{DS(on)}$ (<3,5 мОм)
- Оптимизированные цепи управления (затвор-исток)
- AlN подложки
- AlSiC основание
- Малая тепловая связь между кристаллами.

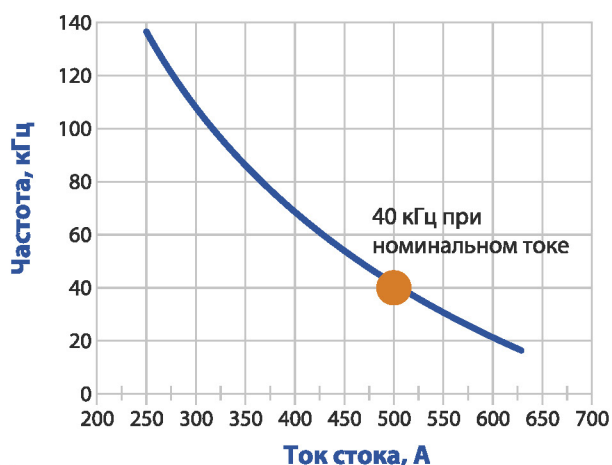
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ:

- Стандартный корпус
- Низкие потери проводимости и переключения
- Быстрая и чистая коммутация с минимальным перенапряжением и осцилляциями
- Оптимальное распределение тока между кристаллами
- Низкое тепловое сопротивление
- Высокие показатели термоциклирования

ПРЕИМУЩЕСТВА НА СИСТЕМНОМ УРОВНЕ:

- Высокая рабочая частота
- Гибкая и компактная конструкция
- Снижение стоимости системы

КРИВАЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ И ТОКА



ТОПОЛОГИЯ ПОЛНОГО МОСТА НА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХСЯ ЯЧЕЙКАХ

